Homework #20

20221059 정상목

1. 과제 목표

Potential, electron, hole에서 Greenfunction을 이용하여 G값을 구하자.

2. Mesh

이번 과제에서 사용할 mesh는 다음과 같습니다.

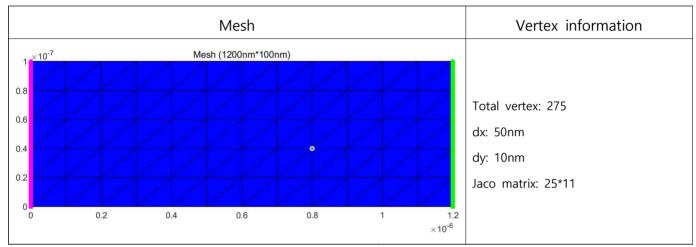


Fig 1. N-type bar

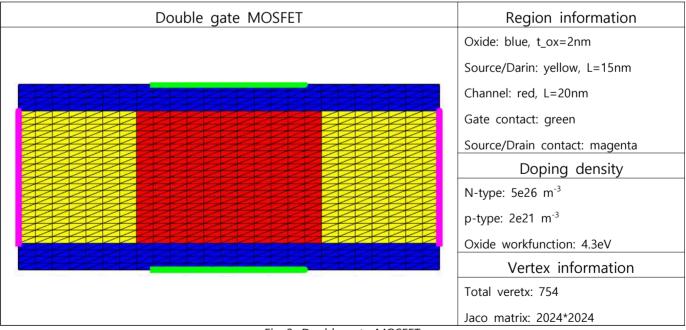


Fig 2. Double_gate_MOSFET

다음과 같이 2가지 경우에 대한 mesh를 계산했습니다. N_type bar의 경우 r_0 를 모든 지점에서 측정하여 G값을 구해주었습니다. Doublegate MOSFET의 경우 결과가 정상적으로 나오지 않아 수정이 필요합니다.

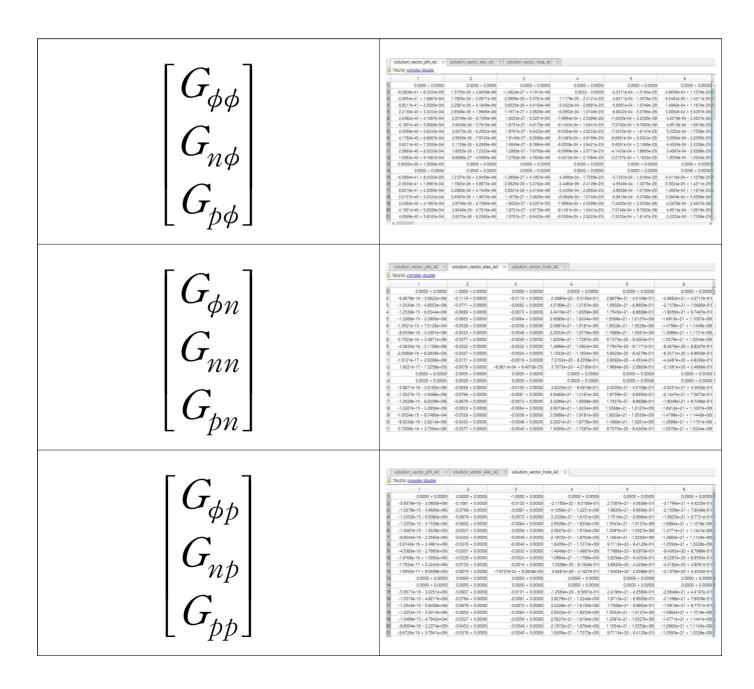
3. Result

3.1. N_type bar

N_type bar에서 모든 지점 r_0 에 대해 excitation 되었을 때의 G값을 구해주기 위해 b vector를 다음과 같이 구성했습니다.

$$b \; vector = egin{bmatrix} 1 & 0 & ... & 0 & 0 \ 0 & 1 & & & \ ... & ... & 0 & 1 \ 0 & & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

물론 다음과 같이 b vector를 구성한 후 Boundary condition을 모두 고려해주었습니다. 다음과 같이 b vector를 구성함으로써 한번의 계산으로 G값을 모두 구할 수 있었습니다. 구해진 결과는 다음과 같습니다.



G 값은 계산으로 값이 나왔으나, 이것이 의미하는 것은 더 공부해야할 것 같습니다. 특히 n,p또한 복소수로 나오게 되는데, 이것이 어떤 것을 의미하는지 더 확인해야합니다. 또한 지금 Doublegate에서 smallsignal를 주었을 때 수렴하지 않는 현상이 있습니다. 코드상의 문제인 것으로 생각되어 이를 수정중에 있습니다. 코드가 정확한 것을 확인하기 위해서 PN접합인 구조를 만들어 확인해볼 예정입니다.